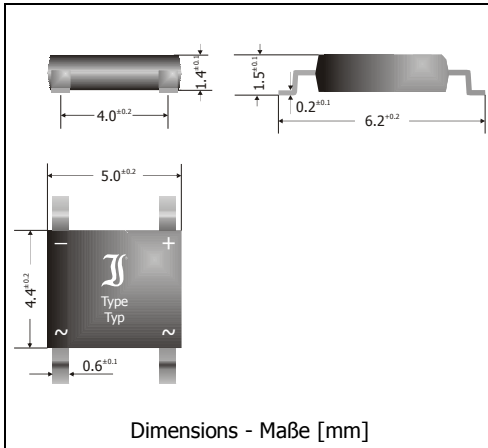


ABS2 ... ABS10

Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers with 4mm Pitch Si-Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage mit 4mm Raster

Version 2013-01-21



Nominal current – Nennstrom 0.8 A

Alternating input voltage
Eingangswechselspannung 140...700 VPlastic case
Kunststoffgehäuse ABSWeight approx.
Gewicht ca. 0.1 gPlastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Green Molding
Halogen-Free

Maximum ratings and Characteristics

Type Typ	Max. altern. input voltage Max. Eingangswechselspg.	Rep. peak reverse voltage Periodische Spitzensperisp.
	V_{VRMS} [V]	V_{RRM} [V] ¹⁾
ABS2	140	200
ABS4	280	400
ABS6	420	600
ABS8	560	800
ABS10	700	1000

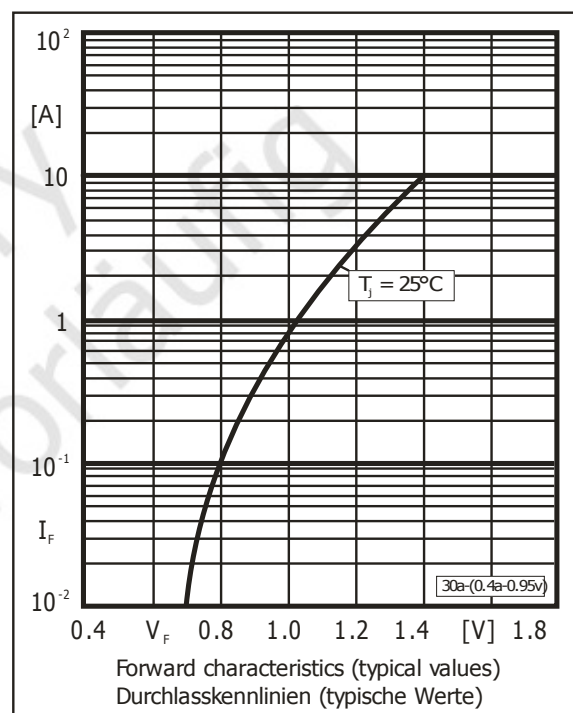
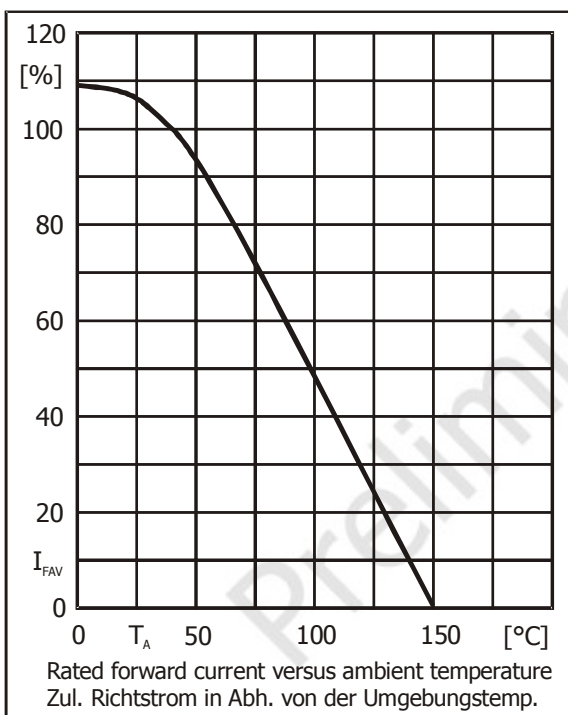
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	5.4 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	27/30 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	3.6 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

1 Valid per diode – Gültig pro Diode

2 Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom	$T_A = 40^\circ\text{C}$		I_{FAV} I_{FAV}	$0.8\text{ A}^1)$ $1\text{ A}^2)$
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 0.4\text{ A}$ $I_F = 0.8\text{ A}$	V_F V_F	$< 0.95\text{ V}^3)$ $< 1.1\text{ V}^3)$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 5\ \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA} R_{thA}	$< 80\text{ K/W}^1)$ $< 62\text{ K/W}^2)$
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss			R_{thT}	$< 25\text{ K/W}$



- 1 Mounted on P.C. Board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss
- 2 Mounted on Alumina Substrate 2500mm² with 1 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Aluminium-Substrat 2500mm² mit 1 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss
- 3 Valid per diode – Gültig pro Diode